

日程表(分科別1)

大分類分科名 中分類分科名 S シンポジウム	2022年3月22日(火)		2022年3月23日(水)		2022年3月24日(木)		2022年3月25日(金)		2022年3月26日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
NT1 就活生必見! カーボンニュートラルは半導体が切り拓く					E201 09:30 ~ 11:40					
NT2 ジェンダー・イノベーションを通して考える応用物理の男女共同参画						E305 13:30 ~ 18:00				
T1 SDGs を意識した物理教育を目指して						E301 13:30 ~ 16:55				
T2 放射線分野における機械学習の利用				F307 13:00 ~ 16:15						
T3 放射線誘起蛍光体の基礎と応用						F307 13:00 ~ 17:15				
T4 蛍光体エネルギー-移動エンジニアリング		E103 13:30 ~ 16:25								
T5 レーザープロセシング技術×AIの最新研究動向				E304 13:30 ~ 16:45						
T6 プローブ顕微鏡を用いたナノスケール化学分光の最前線		E201 13:30 ~ 17:25								
T7 オンライン時代の機能性マテリアル ~beyond5G/6Gに向けて~						E201 13:30 ~ 17:35				
T8 ダイヤモンドNV センタを用いた固体量子センサの最新研究動向				E305 13:30 ~ 18:05						
T9 可視光からX線によるイメージング -その汎用性の探求-	E304 09:00 ~ 11:35	E304 13:30 ~ 17:00								
T10 プラズマ・液体相互作用~基礎と応用の最新動向				E103 13:30 ~ 18:05						
T11 トポロジカル材料科学の拓く新機能・新物性			E201 09:30 ~ 11:40	E201 13:15 ~ 16:30						
T12 スピントロニクスによるグリーンイノベーション							E201 13:30 ~ 17:15			
T13 医療に貢献する超伝導技術の現状と展望		E305 13:30 ~ 17:30								
T14 多元化合物の光機能・エネルギー変換材料としての魅力	E301 10:00 ~ 12:00	E301 13:30 ~ 16:45								
T15 二次元材料を集積回路に!						E304 13:00 ~ 17:45				
T16 生産現場におけるIoTデバイス技術活用の最新動向							E103 13:30 ~ 16:50			
T17 結晶シリコン太陽電池技術の今後~カーボンニュートラル実現に向けて~				E301 13:30 ~ 17:40						
T18 一次元・二次元融合物質系: ナノチューブ・原子層・ヘテロ積層の科学				E101 13:30 ~ 17:30						
T19 応用物理におけるインフォマティクス応用の最前線	E101 10:00 ~ 12:00	E101 13:30 ~ 16:15								
T20 量子コンピュータ: システム構築のための技術と期待されるアプリケーション(II)						E101 13:30 ~ 18:05				
T21 2050年カーボンニュートラル: これから何をすべきなのか?							E101 13:30 ~ 17:25			
FS フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」										
FS.1 フォーカストセッション「AIエレクトロニクス」	E102 09:00 ~ 11:15	E102 13:30 ~ 17:30	E102 09:00 ~ 11:30	E102 13:30 ~ 17:15						
CS コードシェアセッション										
CS.1 2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析、7.5 イオンビーム一般のコードシェアセッション						F308 13:30 ~ 16:30	F308 10:30 ~ 11:30	F308 13:00 ~ 15:45		
CS.2 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション						D215 13:00 ~ 14:45				
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象、3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション						E303 13:15 ~ 16:00				
CS.4 3.11 フォトニック構造・現象、3.13 半導体光デバイスのコードシェアセッション							E303 09:30 ~ 12:00			
CS.5 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション						E105 13:30 ~ 17:00				
CS.6 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション									E206 13:00 ~ 17:15	
CS.7 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V 族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎のコードシェアセッション					D316 09:00 ~ 11:30					
CS.8 12.6 ナノバイオテクノロジー、12.7 医用工学・バイオチップのコードシェアセッション						E104 13:00 ~ 17:45				
CS.9 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価、15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシェアセッション		E302 13:45 ~ 18:30	E302 09:00 ~ 12:00	E302 13:30 ~ 18:30	E302 09:00 ~ 12:30	E302 14:00 ~ 18:15	E301 09:00 ~ 11:30	E301 13:00 ~ 15:15		
1 応用物理学一般										
1.1 応用物理一般・学際領域		F407 13:00 ~ 17:15							P01 09:30 ~ 11:30	
1.2 教育									P02 09:30 ~ 11:30	E307 13:30 ~ 16:00
1.3 新技術・複合新領域	P01 09:30 ~ 11:30					D316 13:00 ~ 16:45				
1.4 エネルギー変換・貯蔵・資源・環境	E106 09:00 ~ 10:00 P02 09:30 ~ 11:30	E106 13:30 ~ 18:00								
1.5 計測技術・計測標準						D113 13:00 ~ 18:00	P01 09:30 ~ 11:30			
1.6 超音波	P03 09:30 ~ 11:30			D113 13:00 ~ 18:15						
2 放射線										
2.1 検出器デバイス開発	F308 09:15 ~ 12:00	F308 13:30 ~ 17:00								
2.2 放射線物理一般・放射線応用・発生装置・新技術		F307 13:00 ~ 16:15	F307 09:00 ~ 11:30							
2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析 ※7.5 イオンビーム一般とのコードシェアセッション					P01 09:30 ~ 11:30	F308 13:30 ~ 16:30	F308 10:30 ~ 11:30	F308 13:00 ~ 15:45		
2.4 医用応用							D113 09:00 ~ 12:00			
2.5 放射線誘起蛍光体							F407 09:00 ~ 11:30	F407 13:00 ~ 17:15		

日程表(分科別2)

大分類分科名 中分類分科名 3 光・フォトニクス	2022年3月22日(火)		2022年3月23日(水)		2022年3月24日(木)		2022年3月25日(金)		2022年3月26日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
3.1 光学基礎・光学新領域	D315 10:00 ~ 11:30	D315 13:00 ~ 17:45	D315 09:00 ~ 12:00	P01 13:30 ~ 15:30						
3.2 材料・機器光学							P07 16:00 ~ 18:00		E205 09:00 ~ 11:30	
3.3 情報フォトニクス・画像工学	P04 09:30 ~ 11:30			D315 13:00 ~ 17:45						
3.4 生体・医用光学							D315 09:00 ~ 11:30	P08 16:00 ~ 18:00	E204 09:00 ~ 11:30	E204 13:00 ~ 16:30
3.5 レーザー装置・材料						P05 16:00 ~ 18:00	D215 10:00 ~ 11:30	D215 13:30 ~ 17:00		
CS.2 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション						D215 13:00 ~ 14:45				
3.6 超高速・高強度レーザー					D315 09:00 ~ 11:30	D315 13:00 ~ 16:15	D316 09:00 ~ 11:30	D316 13:00 ~ 16:45		
3.7 レーザープロセッシング			E304 09:00 ~ 12:00		E106 09:00 ~ 12:00	E106 13:30 ~ 18:30				
3.8 光計測技術・機器						P06 16:00 ~ 18:00	E302 09:00 ~ 11:35	E302 13:15 ~ 18:30	E302 09:00 ~ 12:00	E302 13:30 ~ 17:00
3.9 テラヘルツ全般						P07 16:00 ~ 18:00		D315 13:00 ~ 18:00	E101 09:30 ~ 11:00	E101 13:00 ~ 16:00
3.10 光子物理・技術						P08 16:00 ~ 18:00	D214 09:30 ~ 11:30	D214 13:00 ~ 17:30		
3.11 フォトニック構造・現象					E301 09:15 ~ 12:00	P09 16:00 ~ 18:00		E303 13:30 ~ 17:15	E303 09:15 ~ 12:00	E303 13:30 ~ 16:15
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象、3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション						E303 13:15 ~ 16:00				
CS.4 3.11 フォトニック構造・現象、3.13 半導体光デバイスのコードシェアセッション							E303 09:30 ~ 12:00			
3.12 ナノ領域光科学・近接場光学	E103 09:00 ~ 11:15	P01 13:30 ~ 15:30	E303 09:00 ~ 12:00	E303 13:30 ~ 17:45	E303 09:00 ~ 12:00	E303 16:15 ~ 17:45				
CS.3 3.11 フォトニック構造・現象、3.12 ナノ領域光科学・近接場光学のコードシェアセッション						E303 13:15 ~ 16:00				
3.13 半導体光デバイス								P09 16:00 ~ 18:00	E301 09:30 ~ 12:00	E301 13:30 ~ 17:00
CS.4 3.11 フォトニック構造・現象、3.13 半導体光デバイスのコードシェアセッション							E303 09:30 ~ 12:00			
3.14 光制御デバイス・光ファイバー	D215 09:00 ~ 11:30	D215 13:00 ~ 16:00		P02 13:30 ~ 15:30						
CS.2 3.5 レーザー装置・材料、3.14 光制御デバイス・光ファイバーのコードシェアセッション						D215 13:00 ~ 14:45				
3.15 シリコンフォトニクス・集積フォトニクス	E303 09:30 ~ 12:00	E303 13:30 ~ 17:15		P03 13:30 ~ 15:30						
3.16 Optics and Photonics English Session						D214 13:00 ~ 16:00				
6 薄膜・表面										
6.1 強誘電体薄膜				P04 13:30 ~ 15:30			E305 09:00 ~ 12:00	E305 13:30 ~ 18:30		
CS.5 6.1 強誘電体薄膜、13.3 絶縁膜技術、13.5 デバイス/配線/集積化技術のコードシェアセッション						E105 13:30 ~ 17:00				
6.2 カーボン系薄膜				P05 13:30 ~ 15:30		E204 13:30 ~ 16:15	E204 09:00 ~ 12:00	E204 13:30 ~ 18:15		
6.3 酸化物エレクトロニクス	E204 09:30 ~ 12:00	E204 13:30 ~ 17:00	E204 09:00 ~ 12:00	E204 13:30 ~ 17:00	E204 09:30 ~ 11:45			P01 13:30 ~ 15:30		
6.4 薄膜新材料				P06 13:30 ~ 15:30	F307 09:15 ~ 11:30		F307 09:15 ~ 11:30	F307 13:30 ~ 18:00		
6.5 表面物理・真空								P02 13:30 ~ 15:30	E206 10:30 ~ 11:45	
CS.6 6.5 表面物理・真空、7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術のコードシェアセッション										E206 13:00 ~ 17:15
6.6 プローブ顕微鏡								P03 13:30 ~ 15:30	E105 09:00 ~ 12:00	E105 13:30 ~ 16:45
7 ビーム応用										
7.1 X線技術					E101 10:00 ~ 11:45	E202 13:30 ~ 15:30				
7.2 電子ビーム応用									F308 09:00 ~ 11:15	
7.3 微細パターン・微細構造形成技術		P04 16:00 ~ 18:00								F308 13:00 ~ 14:00
7.4 量子ビーム界面構造計測										
7.5 イオンビーム一般						F308 13:30 ~ 16:30	F308 10:30 ~ 11:30	F308 13:00 ~ 15:45		
※2.3 加速器質量分析・加速器ビーム分析とのコードシェアセッション										
7.6 原子・分子線およびビーム関連新技術										E206 13:00 ~ 17:15
※6.5 表面物理・真空とのコードシェアセッション										
8 プラズマエレクトロニクス										
8.1 プラズマ生成・診断		E105 13:00 ~ 18:00								
8.2 プラズマ成膜・エッチング・表面処理							E104 09:00 ~ 12:00	E104 13:00 ~ 18:30		
8.3 プラズマナノテクノロジー						D114 13:00 ~ 16:15				
CS.7 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V 族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎のコードシェアセッション					D316 09:00 ~ 11:30				P03 09:30 ~ 11:30	
8.4 プラズマライフサイエンス							E105 09:30 ~ 11:45	E105 13:30 ~ 17:15		
8.5 プラズマ現象・新応用・融合分野			E103 09:15 ~ 12:00		D113 09:30 ~ 10:45					
8.6 Plasma Electronics English Session					D113 10:45 ~ 11:00					
8.7 プラズマエレクトロニクス分科内招待講演										
9 応用物性										
9.1 誘電材料・誘電体							P02 09:30 ~ 11:30		E307 09:00 ~ 11:30	
9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート					F408 09:00 ~ 11:15	F408 13:00 ~ 16:00		P10 16:00 ~ 18:00		
CS.7 8.3 プラズマナノテクノロジー、9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノシート、13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス、15.3 III-V 族エピタキシャル結晶・エピタキシーの基礎のコードシェアセッション					D316 09:00 ~ 11:30					
9.3 ナノエレクトロニクス									E305 09:00 ~ 11:15	E305 13:00 ~ 15:00
9.4 熱電変換					E205 09:00 ~ 12:00	E205 13:30 ~ 18:30		P04 13:30 ~ 15:30		
9.5 新機能材料・新物性	D214 09:45 ~ 11:30	D214 13:00 ~ 17:00		P08 16:00 ~ 18:00						

日程表(分科別3)

大分類分科名 中分類分科名	2022年3月22日(火)		2022年3月23日(水)		2022年3月24日(木)		2022年3月25日(金)		2022年3月26日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
10 スピントロニクス・マグネティクス										
10.1 新物質・新機能創成 (作製・評価技術)		E205 13:45 ~ 18:15	E205 09:15 ~ 12:00							
10.2 スピン基盤技術・萌芽的デバイス技術						P01 13:30 ~ 15:30			E201 09:00 ~ 12:15	E201 13:45 ~ 17:00
10.3 スピンデバイス・磁気メモリ・ストレージ技術							E202 16:00 ~ 18:30	E201 09:00 ~ 12:00		
10.4 半導体・トポロジカル・超伝導・強相関スピントロニクス				E205 13:30 ~ 18:30		P01 13:30 ~ 15:30				
10.5 磁場応用	E205 09:00 ~ 12:15									
11 超伝導										
11.1 基礎物性				D215 13:30 ~ 18:00						
11.2 薄膜, 厚膜, テープ作製プロセスおよび結晶成長			D215 09:00 ~ 11:45							
11.3 臨界電流, 超伝導パワー応用	P05 09:30 ~ 11:30			E203 13:00 ~ 16:15						
11.4 アナログ応用および関連技術			D214 09:00 ~ 11:00		D214 09:00 ~ 10:30					
11.5 接合, 回路作製プロセスおよびデジタル応用				D214 13:00 ~ 18:00						
12 有機分子・バイオエレクトロニクス										
12.1 作製・構造制御							E205 09:30 ~ 12:00	E205 13:30 ~ 17:15	P04 09:30 ~ 11:30	
12.2 評価・基礎物性						P02 13:30 ~ 15:30	E304 09:00 ~ 11:30	E304 13:45 ~ 18:00	E304 09:15 ~ 11:45	E304 13:30 ~ 16:30
12.3 機能材料・萌芽的デバイス	E307 09:00 ~ 12:00	E307 13:30 ~ 17:30	P01 09:30 ~ 11:30	D114 13:00 ~ 16:05	E307 09:00 ~ 11:45	E307 13:30 ~ 16:30				
12.4 有機EL・トランジスタ	E206 10:30 ~ 12:00	E206 13:30 ~ 17:15	E206 09:00 ~ 11:45	E206 13:30 ~ 17:00						
12.5 有機太陽電池				P10 16:00 ~ 18:00	E206 09:00 ~ 12:15	E206 13:30 ~ 16:45	E206 09:30 ~ 12:00	E206 13:30 ~ 16:00		
12.6 ナノバイオテクノロジー			E104 09:00 ~ 11:30	E104 13:00 ~ 17:30	E104 09:00 ~ 11:15		P03 09:30 ~ 11:30			
CS.8 12.6 ナノバイオテクノロジー, 12.7 医用工学・バイオチップの コードシェアセッション							E104 13:00 ~ 17:45			
12.7 医用工学・バイオチップ			E105 09:00 ~ 12:00	E105 13:30 ~ 17:45	E105 09:00 ~ 11:45		P04 09:30 ~ 11:30			
CS.8 12.6 ナノバイオテクノロジー, 12.7 医用工学・バイオチップの コードシェアセッション							E104 13:00 ~ 17:45			
13 半導体										
13.1 Si系基礎物性・表面界面・シミュレーション	E105 09:30 ~ 11:30			P11 16:00 ~ 18:00						
13.2 探索的材料物性・基礎物性		P05 16:00 ~ 18:00	F308 09:00 ~ 11:45	F308 13:15 ~ 17:00						
13.3 絶縁膜技術								P05 13:30 ~ 15:30	E103 09:00 ~ 11:30	
CS.5 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配 線/集積化技術のコードシェア							E105 13:30 ~ 17:00			
13.4 Si系プロセス・Si系薄膜・MEMS・装置技術					E103 09:00 ~ 12:30	E103 13:30 ~ 18:00	E103 09:30 ~ 12:00			
13.5 デバイス/配線/集積化技術			E307 09:00 ~ 12:00	E307 13:30 ~ 19:00					E307 13:30 ~ 17:30	
CS.5 6.1 強誘電体薄膜, 13.3 絶縁膜技術, 13.5 デバイス/配 線/集積化技術のコードシェアセッション							E105 13:30 ~ 17:00			
13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス		P02 13:30 ~ 15:30		D316 13:00 ~ 17:45						
CS.7 8.3 プラズマナノテクノロジー, 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノ シート, 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス, 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶・エビタキシーの基礎のコードシェアセッション					D316 09:00 ~ 11:30					
13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価	E302 09:00 ~ 12:15								P11 16:00 ~ 18:00	
CS.9 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価, 15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシェアセッション		E302 13:45 ~ 18:30	E302 09:00 ~ 12:00	E302 13:30 ~ 18:30	E302 09:00 ~ 12:30	E302 14:00 ~ 18:15	E301 09:00 ~ 11:30	E301 13:00 ~ 15:15		
13.8 光物性・発光デバイス	D316 09:30 ~ 11:15	D316 13:00 ~ 17:15	P03 09:30 ~ 11:30							
13.9 化合物太陽電池			E106 09:00 ~ 12:00	E106 13:30 ~ 18:45			P03 13:30 ~ 15:30			
15 結晶工学										
15.1 バルク結晶成長							P05 09:30 ~ 11:30	F408 13:00 ~ 17:15		
15.2 II-VI族結晶および多元系結晶								D113 13:00 ~ 14:15		
15.3 III-V族エピタキシャル結晶・エビタキシーの基礎			F407 09:00 ~ 11:15	P07 13:30 ~ 15:30						
CS.7 8.3 プラズマナノテクノロジー, 9.2 ナノ粒子・ナノワイヤ・ナノ シート, 13.6 ナノ構造・量子現象・ナノ量子デバイス, 15.3 III-V 族エピタキシャル結晶・エビタキシーの基礎のコードシェアセッション					D316 09:00 ~ 11:30					
15.4 III-V族窒化物結晶	E202 10:00 ~ 12:00	E202 13:30 ~ 18:15	E202 09:15 ~ 12:00	E202 14:15 ~ 18:15	E202 09:15 ~ 12:00	P04 13:30 ~ 15:30	E203 09:00 ~ 12:00	E203 13:30 ~ 18:15	E203 09:00 ~ 12:00	E203 14:15 ~ 17:15
15.5 IV族結晶, IV-IV族混晶							D114 09:30 ~ 11:15	D114 13:00 ~ 17:15	P05 09:30 ~ 11:30	
15.6 IV族系化合物 (SiC)								P12 16:00 ~ 18:00		
CS.9 13.7 化合物及びパワーデバイス・プロセス技術・評価, 15.6 IV族系化合物 (SiC) のコードシェアセッション		E302 13:45 ~ 18:30	E302 09:00 ~ 12:00	E302 13:30 ~ 18:30	E302 09:00 ~ 12:30	E302 14:00 ~ 18:15	E301 09:00 ~ 11:30	E301 13:00 ~ 15:15		
15.7 結晶評価, 不純物・結晶欠陥								P06 13:30 ~ 15:30	E104 09:00 ~ 12:00	E104 13:30 ~ 16:30
16 非晶質・微結晶										
16.1 基礎物性・評価・プロセス・デバイス	F408 09:00 ~ 11:30	F408 13:00 ~ 16:45	F408 09:00 ~ 11:30							
16.2 エナジーハーベスティング									F407 09:00 ~ 10:00	
16.3 シリコン系太陽電池							P10 16:00 ~ 18:00		F408 09:30 ~ 12:00	F408 13:30 ~ 16:30

日程表(分科別4)

大分類分科名 中分類分科名	2022年3月22日(火)		2022年3月23日(水)		2022年3月24日(木)		2022年3月25日(金)		2022年3月26日(土)	
	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後	午前	午後
17 ナノカーボン										
17.1 カーボンナノチューブ, 他のナノカーボン材料		P03 13:30 ~ 15:30	E203 09:00 ~ 12:00			E102 13:30 ~ 18:15			E102 09:00 ~ 10:30	
		P06 16:00 ~ 18:00								
17.2 グラフェン		P03 13:30 ~ 15:30					E102 11:15 ~ 12:00	E102 13:30 ~ 18:30		
		P06 16:00 ~ 18:00								
17.3 層状物質	E203 09:00 ~ 12:00	P03 13:30 ~ 15:30	E101 09:00 ~ 12:00		E102 09:00 ~ 11:45		E102 09:45 ~ 11:00			
		P06 16:00 ~ 18:00								
21 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」										
21.1 合同セッションK「ワイドギャップ酸化物半導体材料・デバイス」				P12 16:00 ~ 18:00			E202 09:30 ~ 12:00	E202 13:30 ~ 17:30	E202 09:00 ~ 11:30	E202 13:00 ~ 16:45
22 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」										
22.1 合同セッションM「フォノンエンジニアリング」					F407 09:15 ~ 12:00	F407 13:15 ~ 18:00				
23 合同セッションN「インフォマティクス応用」										
23.1 合同セッションN「インフォマティクス応用」					E203 09:00 ~ 11:45	E203 13:30 ~ 18:00	P06 09:30 ~ 11:30			